

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-21347

(43)公開日 平成5年(1993)1月29日

(51)Int.Cl.⁵
H 01 L 21/203
C 23 C 14/34
14/54

識別記号 S
府内整理番号 8422-4M
8414-4K
8414-4K

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2(全6頁)

(21)出願番号 特願平3-171200

(22)出願日 平成3年(1991)7月11日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 小林 雅也

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

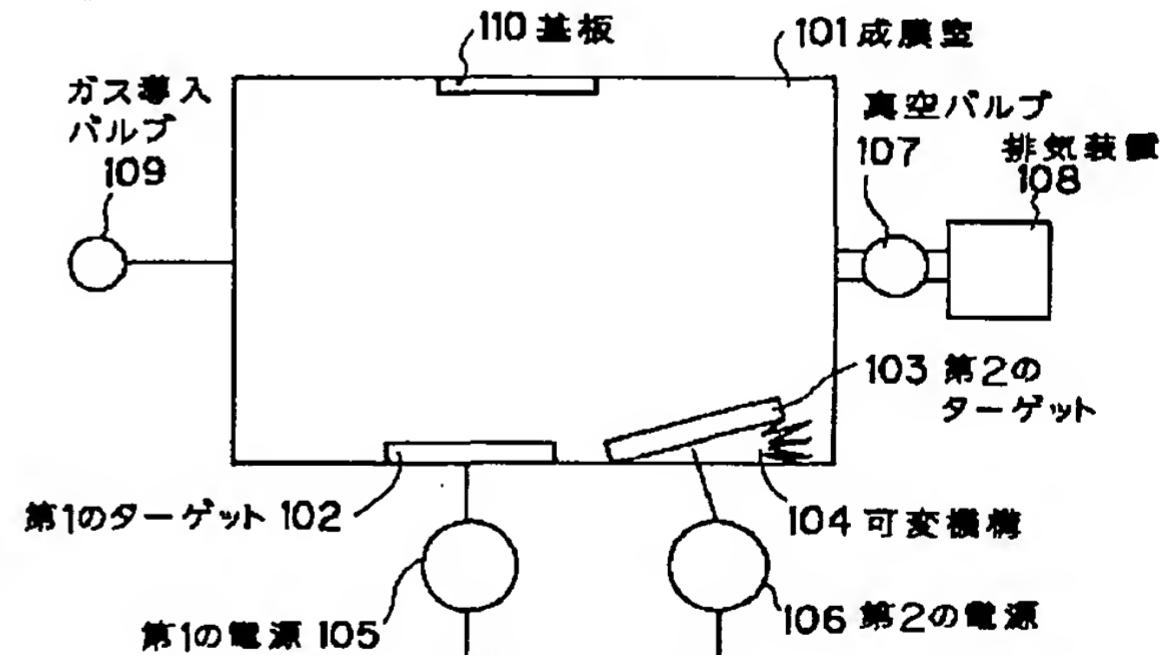
(74)代理人 弁理士 若林 忠

(54)【発明の名称】スパッタリング装置

(57)【要約】

【目的】膜の堆積速度や組成が安定化され、高効率かつ低コストで成膜することのできるスパッタリング装置を実現すること。

【構成】基板とターゲットとを対向配置し、ターゲットから放出された構成粒子を基板上に堆積させて成膜を行うスパッタリング装置において、前記ターゲットの前記基板に対する距離および角度を調節可能とするための、前記ターゲットを搭載する可変機構が設けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板とターゲットとを対向配置し、ターゲットから放出された構成粒子を基板上に堆積させて成膜を行うスパッタリング装置において、

前記ターゲットの前記基板に対する距離および角度を調節可能とするための、前記ターゲットを搭載する可変機構が設けられていることを特徴とするスパッタリング装置。

【請求項2】 請求項1記載のスパッタリング装置において、

基板と対向配置されるターゲットが複数設けられており、少なくとも1つのターゲットは個別に設けられた可変機構上に搭載されていることを特徴とするスパッタリング装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は基板上に構成粒子を堆積させて成膜を行うスパッタリング装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 スパッタリング装置では、ターゲットから放出されて飛散する構成粒子を基板上に堆積させることによって成膜が行われる。このターゲット表面は成膜動作によって次第に削られるため、構成粒子の飛び方も著しく変化し、基板上に形成される膜の堆積速度や組成が成膜動作の初期時のものと異なってしまう。このような変化を防ぐために従来よりターゲットに加える電力を変化させ、構成粒子の飛ぶ量を調節することが行われていた。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 従来のスパッタリング装置は、基板上に形成される膜の堆積速度や組成が変化することを防ぐために、ターゲットに加える電力を変化させて構成粒子の飛ぶ量を調節するものである。しかしながら、構成粒子の飛ぶ量が変化してもその飛散方向自体は変化しないため、膜の堆積速度や組成の変化を十分に抑えることができないという問題点がある。また、構成粒子が基板以外の方向に飛散してしまうため、ターゲットの消費が激しく、生産効率が悪いうえに基板の製造コストが高くなるという問題点がある。

【0004】 本発明は上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、膜の堆積速度や組成が安定化され、高効率かつ低成本で成膜するとのできるスパッタリング装置を実現することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明のスパッタリング装置は、基板とターゲットとを対向配置し、ターゲットから放出された構成粒子を基板上に堆積させて成膜を行うスパッタリング装置において、前記ターゲットの前記基板に対する距離および角度を調節可能とするための、

前記ターゲットを搭載する可変機構が設けられている。

【0006】 この場合、基板と対向配置されるターゲットが複数設けられており、少なくとも1つのターゲットは個別に設けられた可変機構上に搭載されるものとしてもよい。

【0007】

【作用】 可変機構により、成膜動作によって変化する構成粒子の飛び方に合わせてターゲットの基板に対する距離および角度を調節することができるので、基板上に形成される膜の堆積速度や組成を成膜動作の初期時と同じものとすることができる。

【0008】

【実施例】 次に、本発明の実施例について、図面を参照して説明する。

【0009】 図1は本発明のスパッタリング装置の第1の実施例の構成を示す図である。

【0010】 本実施例は、1つの成膜室内に構成粒子の飛び方が異なる2つのターゲットを設置し、各ターゲットからの構成粒子によって基板上に成膜を行うものである。

【0011】 成膜室101内には、第1のターゲット102と第2のターゲット103とが基板110に対向配置されている。第1のターゲット102および第2のターゲット103は、第1の電源105および第2の電源106とそれぞれ接続されており、各電源からの電源供給を受けたときに各ターゲットから構成粒子がそれぞれ飛散して成膜がなされる。本実施例においては第1および第2のターゲットとして、成膜時に飛散する構成粒子がターゲット表面の垂直方向に飛散するが多いものを第1のターゲットとして用い、斜め方向に飛散するが多いものを第2のターゲットとして用いる。このため、第2のターゲット103は基板110に対する距離および角度を任意に調節可能な可変機構104上に載置されている。

【0012】 成膜室101内の雰囲気は、真空バルブ107と、成膜室101内を真空バルブ107を介して排気する排気装置108と、成膜室101に所定のガスを供給するガス導入バルブ109とによって制御される。

【0013】 次に、図1に示したスパッタリング装置による成膜動作の具体例について説明する。

【0014】 「具体例1」 図1に示したスパッタリング装置を用いて垂直磁化膜を成膜した。第1のターゲット102として鉄コバルト、第2のターゲット103としてテルビウムを用い、ガラス製の基板110を設置した。続いて成膜室101が 1×10^{-7} Torrになるまで排気装置108によって排気した。次に、ガス導入バルブ109よりスパッタガスであるArガスを成膜室101内の圧力が 2×10^{-3} Torrとなるまで導入した。続いて、第1の電源105および第2の電源106により第1のターゲット102および第2のターゲット103の

それぞれに所定の電力を加えて基板110上にテルビウム鉄コバルト膜を厚さ2000Åまで成膜させた。この後、成膜室101をリークしてガラス基板110を取り出し、膜中のテルビウム原子の濃度を蛍光X線分析装置により測定した。

【0015】図2および図3のそれぞれは、以上の動作を繰り返し行ったときのテルビウム原子濃度および膜厚の経時変化を示すもので、膜質および成膜速度の変化をそれぞれ示す図である。

【0016】各図中、実線で示される線分(a)は可変機構104によって第2のターゲット103からの構成粒子が基板110方向に飛散するように逐次調節したときの経時変化を示し、破線で示される線分(b)は可変機構104を固定したときの経時変化を示している。

【0017】図2に示されるテルビウムの原子濃度は、可変機構104が固定されると線分(b)に示されるように次第に減少してしまうのに対し、可変機構104によって第2のターゲット103の構成粒子の飛散方向を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。

【0018】図3に示される成膜速度は、可変機構104が固定されると線分(b)に示されるように次第に減少してしまうのに対し、可変機構104によって第2のターゲット103の構成粒子の飛散方向を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。

【0019】上記のように本実施例のものにおいては、ターゲットの基板に対する距離および角度を調節することにより、膜の堆積速度や組成を安定化することができた。また、構成粒子が基板方向のみに飛散させるため、ターゲットの消費を抑えることができ、基板の製造コストを低くすることができた。

【0020】図4は、図1に示されるスパッタリング装置による上記の成膜動作を、基板110の設置位置を変えて行ったときのテルビウム原子濃度の経時変化を示す図である。図4においても、図2および図3と同様に実線で示される線分(a)は可変機構104によって第2のターゲット103からの構成粒子が基板110方向に飛散するように調節したときの経時変化を示し、破線で示される線分(b)は可変機構104を固定したときの経時変化を示している。

【0021】テルビウムの原子濃度は、可変機構104が固定されると線分(b)に示されるように次第に増加してしまうのに対し、可変機構104によって第2のターゲット103の構成粒子の飛散方向を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。

【0022】「具体例2」図1に示したスパッタリング装置において、第2のターゲット103としてディスプロシウムを用い、その他の条件は実施例1と全く同様としてディスプロシウム鉄コバルト膜を2000Å成膜させた。この後、成膜質101をリークして基板110を

取り出し、膜中のディスプロシウム原子濃度を実施例1と同様に測定した。

【0023】図5は、以上の動作を繰り返し行ったときのディスプロシウム原子濃度の経時変化を示すもので、膜質の変化を示す図である。

【0024】図中、実線で示される線分(a)は可変機構104によって第2のターゲット103からの構成粒子が基板110方向に飛散するように調節したときの経時変化を示し、破線で示される線分(b)は可変機構104を固定したときの経時変化を示している。

【0025】図5に示されるディスプロシウムの原子濃度は、可変機構104が固定されると線分(b)に示されるように次第に減少してしまうのに対し、可変機構104によって第2のターゲット103の構成粒子の飛散方向を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。

【0026】「具体例3」図6は本発明の第2の実施例の構成を示す図である。

【0027】図6に示すようなスパッタリング装置および合金ターゲットを用いて実施例1と同様の成膜を行った。

【0028】本実施例は、成膜室内に合金ターゲットを設置し、該ターゲットからの構成粒子によって基板上に成膜を行うものである。

【0029】成膜室601内には、テルビウム鉄コバルトであるターゲット602が基板610に対向配置されている。ターゲット602は電源605と接続されており、該電源605からの電源供給を受けたときにターゲット605から構成粒子が飛散して成膜がなされる。ターゲット605はテルビウム鉄コバルトの合金であるため、基板に対しては異なる種類の構成粒子が異なる飛び方に飛散する。これらの各構成粒子の飛び方は、成膜動作にしたがって変化するため、ターゲット603は基板610に対する距離および角度を任意に調節可能な可変機構604上に載置されている。成膜室601内の雰囲気は、図1に示したものと同様に、真空バルブ607と、成膜室601内を真空バルブ607を介して排気する排気装置608と、成膜室601に所定のガスを供給するガス導入バルブ609とによって制御される。

【0030】図7は、成膜動作を繰り返し行ったときの膜中のテルビウム原子濃度の経時変化を示すもので、膜質の変化を示す図である。

【0031】図中、破線で示される線分(a)は可変機構604によってターゲット602を、各構成粒子の飛散方向の変化に応じて調節したときの経時変化を示し、実線で示される線分(b)は可変機構604によりターゲット602と基板610の各面が平行でない一定角度となるように固定したときの経時変化を示し、一点鎖線で示される線分(c)は可変機構604によりターゲット602と基板610の各面が平行となるように固定し

たときの経時変化を示している。

【0032】テルビウム原子濃度は、ターゲット602と基板610の各面が平行に固定されると線分(c)に示されるように次第に減少してしまうのに対し、可変機構604によってターゲット602を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。また、可変機構604によりターゲット602と基板610の各面が平行でない一定角度となるように固定したときは、膜中のテルビウム濃度は低下するものの、平行に固定されたときに比べると低下する割合は小さなため、製品の歩留りは向上する。
10

【0033】「具体例4」図8は本発明の第3の実施例の構成を示す図である。

【0034】図8に示すようなスパッタリング装置を用いて実施例1と同様の成膜を行った。

【0035】本実施例は、1つの成膜室内に構成粒子の飛び方が異なる3つのターゲットを設置し、各ターゲットからの構成粒子によって基板上に成膜を行うものである。
20

【0036】成膜室801内には、第1のターゲット802、第2のターゲット803および第3のターゲット811とが基板810に対向配置されている。第1のターゲット802、第2のターゲット803および第3のターゲット811は、第1の電源805、第2の電源806および第3の電源813とそれぞれ接続されており、各電源からの電源供給を受けたときに各ターゲットから構成粒子がそれぞれ飛散して基板810上に成膜がなされる。本実施例においては第1乃至第3のターゲットとして、成膜時に飛散する構成粒子がターゲット表面の垂直方向に飛散するが多いものを第1のターゲットとして用い、斜め方向に飛散するが多いものを第2および第3のターゲットとして用いる。このため、第2のターゲット803および第3のターゲット811は基板810に対する距離および角度を任意に調節可能な第1の可変機構804および第2の可変機構812上にそれぞれ載置されている。
30

【0037】成膜室801内の雰囲気は、図1および図6のそれぞれに示したものと同様に真空バルブ807と、成膜室801内を真空バルブ807を介して排気する排気装置808と、成膜室801に所定のガスを供給するガス導入バルブ809とによって制御される。
40

【0038】図8に示すスパッタリング装置において、第1のターゲット802としてテルビウムを、第2のターゲット803として鉄を、第3のターゲット811としてコバルトをそれぞれ用い、実施例1と同様の成膜を行った。

【0039】図9および図10は、成膜動作を繰り返し行ったときのテルビウム原子濃度および鉄原子濃度の経時変化をそれぞれ示すもので、膜質の変化を示す図である。
50

【0040】各図中、実線で示される線分(a)は第1の可変機構804および第2の可変機構812によって第2のターゲット803および第3のターゲット811からの各構成粒子が基板810方向に飛散するようにそれぞれ調節したときの経時変化を示し、破線で示される線分(b)は第1の可変機構804および第2の可変機構812を固定としたときの経時変化を示している。

【0041】図9に示されるテルビウム原子濃度および図10に示される鉄原子濃度のそれぞれは、第1の可変機構804および第2の可変機構812が固定されると線分(b)に示されるように次第に減少してしまうのに対し、第1の可変機構804および第2の可変機構812によって第2のターゲット803および第3のターゲット811からの各構成粒子の飛散方向を調節すると線分(a)に示されるように一定となる。

【0042】本実施例においては、第2のターゲット803および第3のターゲット811のそれぞれの基板810に対する距離および角度を個別に調節することができる、膜質の安定度が一層向上した。また、図には示さなかつたが、成膜速度についても同様であった。

【0043】なお、以上説明した各実施例において、可変機構の構造については特に詳しく説明しなかつたが、伸縮可能な3個の駆動機構によって支持するものや3軸にて回転可能なステージ等が考えられ、とくに限定されるものではない。

【0044】

【発明の効果】本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0045】請求項1に記載のものにおいては、ターゲットの基板に対する距離および角度を調節して基板上に形成される膜の堆積速度や組成を成膜動作の初期時と同じとすることができるため、膜の堆積速度や組成を安定化することができ、高効率かつ低成本に成膜することができる効果がある。

【0046】請求項2に記載のものにおいては、複数設けられた各ターゲット毎に、基板に対する距離および角度を調節することができる、上記効果を一層向上したものとすることができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例の構成を示す図である。

【図2】第1の実施例における膜質の変化を示す図である。

【図3】第1の実施例における成膜速度の変化を示す図である。

【図4】図1中の基板110の位置を異ならせたときの膜質の変化を示す図である。

【図5】図1中の第2のターゲット103の種類を異ならせたときの膜質の変化を示す図である。

【図6】本発明の第2の実施例の構成を示す図である。

【図7】第2の実施例における膜質の変化を示す図である。

る。

【図8】本発明の第3の実施例の構成を示す図である。

【図9】第3の実施例における膜質の変化を示す図である。

【図10】第3の実施例における膜質の変化を示す図である。

【符号の説明】

101, 601, 801 成膜室

102, 802 第1のターゲット

103, 803 第2のターゲット

104, 604 可変機構

105, 805 第1の電源

* 106, 806 第2の電源

107, 607, 807 真空バルブ

108, 608, 808 排気装置

109, 609, 809 ガス導入バルブ

110, 610, 810 基板

602 ターゲット

605 電源

804 第1の可変機構

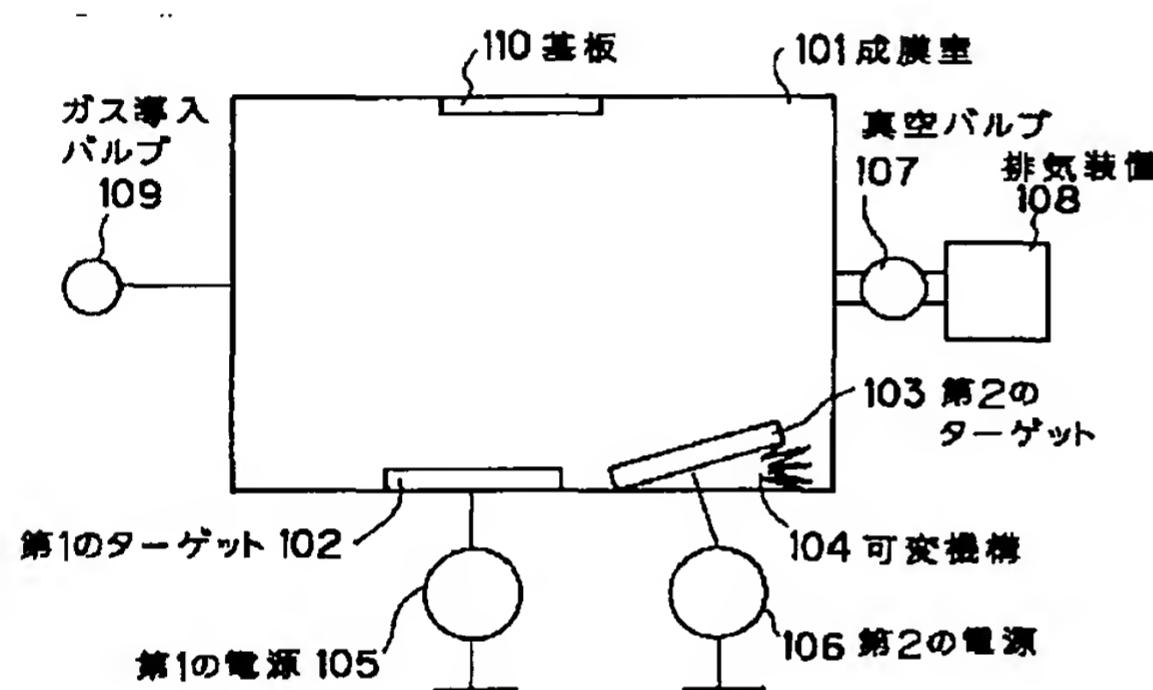
811 第3のターゲット

10 812 第2の可変機構

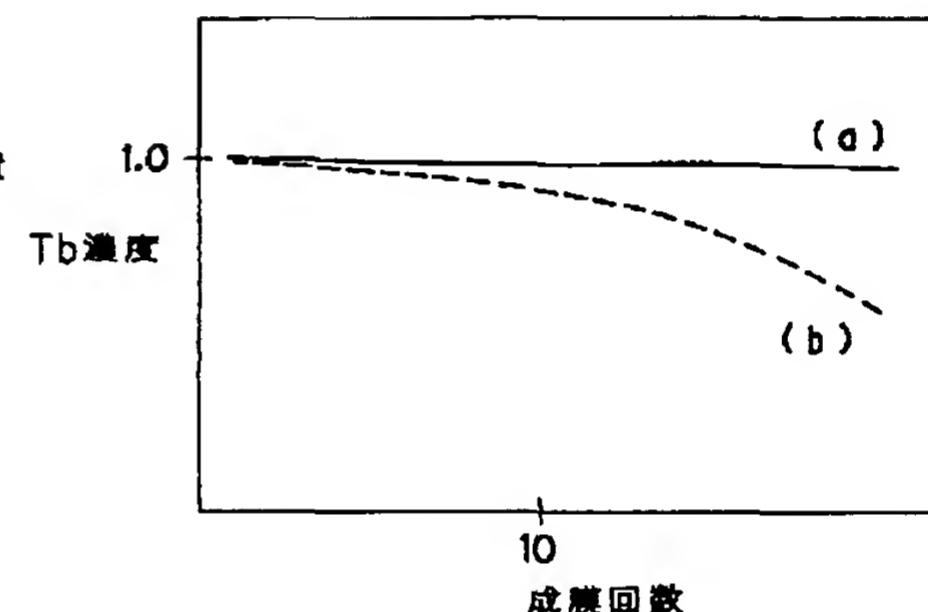
813 第3の電源

*

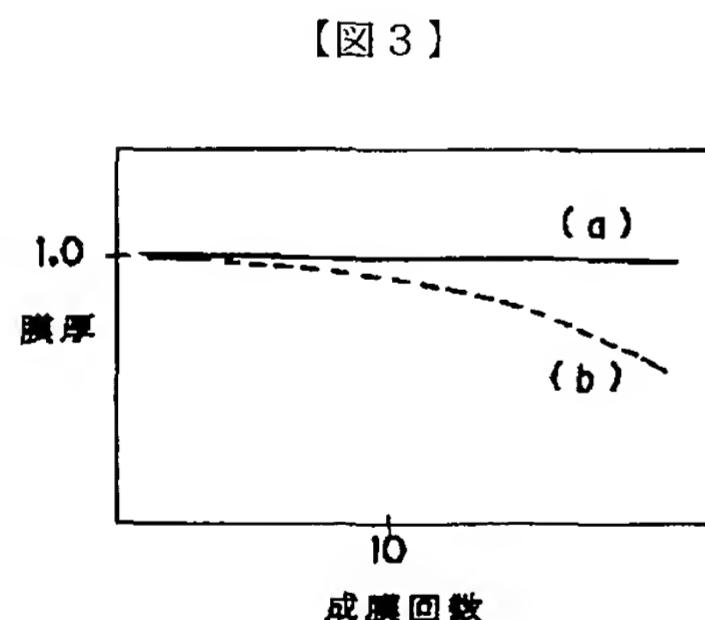
【図1】



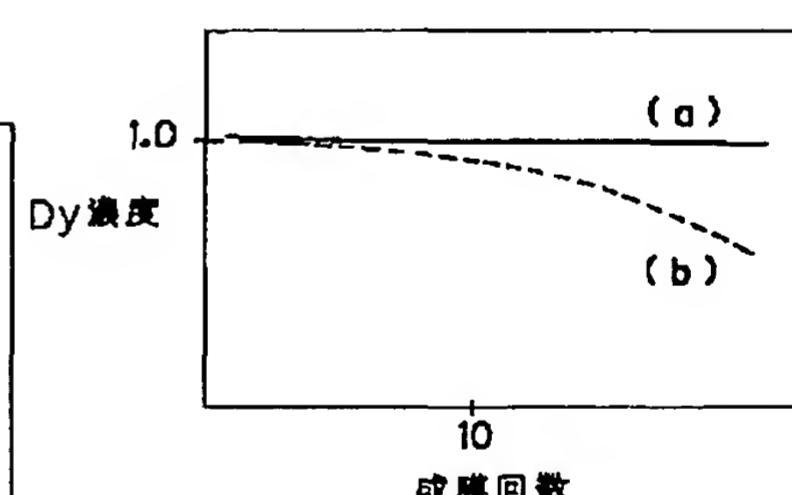
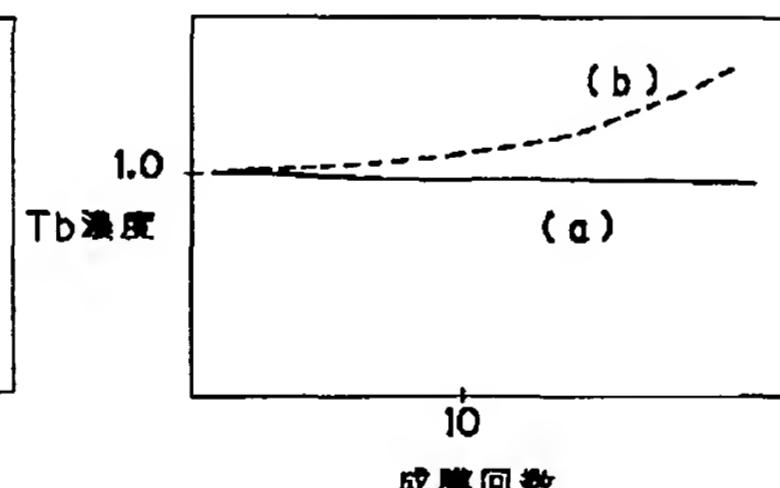
【図2】



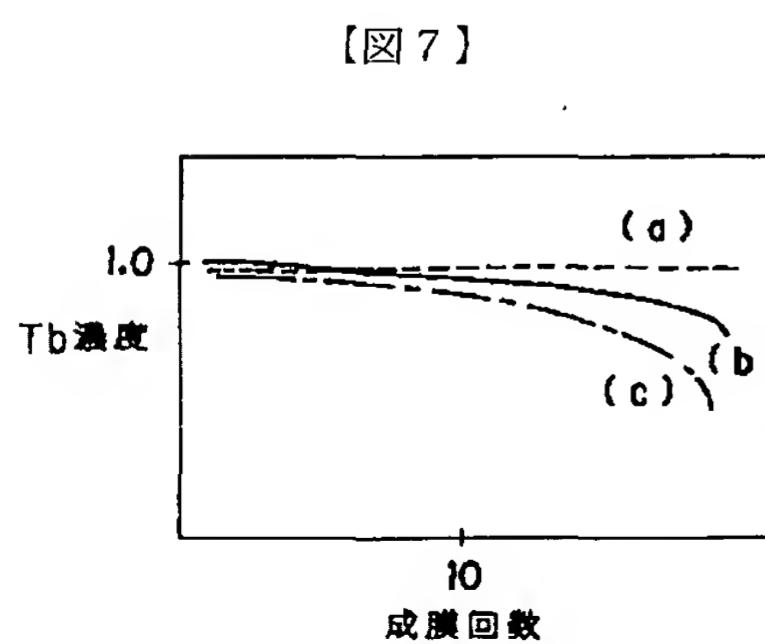
【図5】



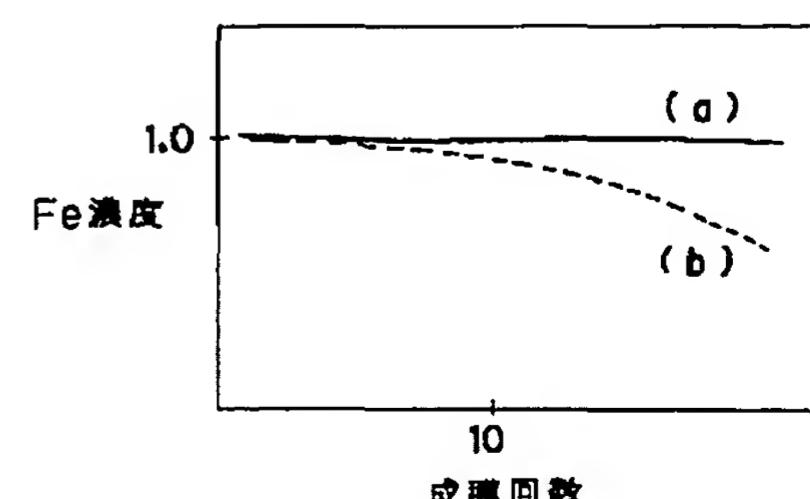
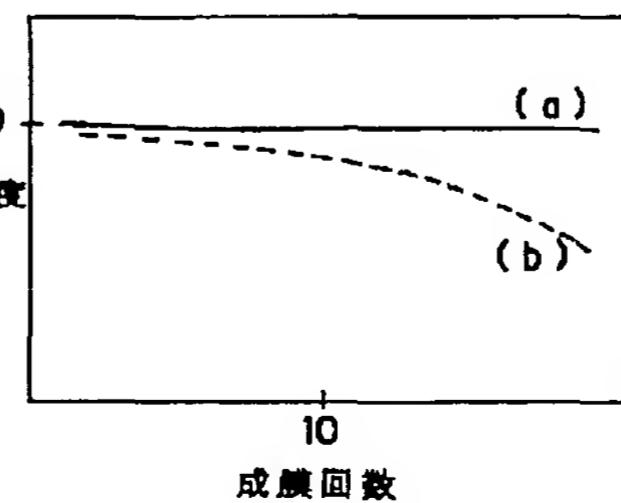
【図4】



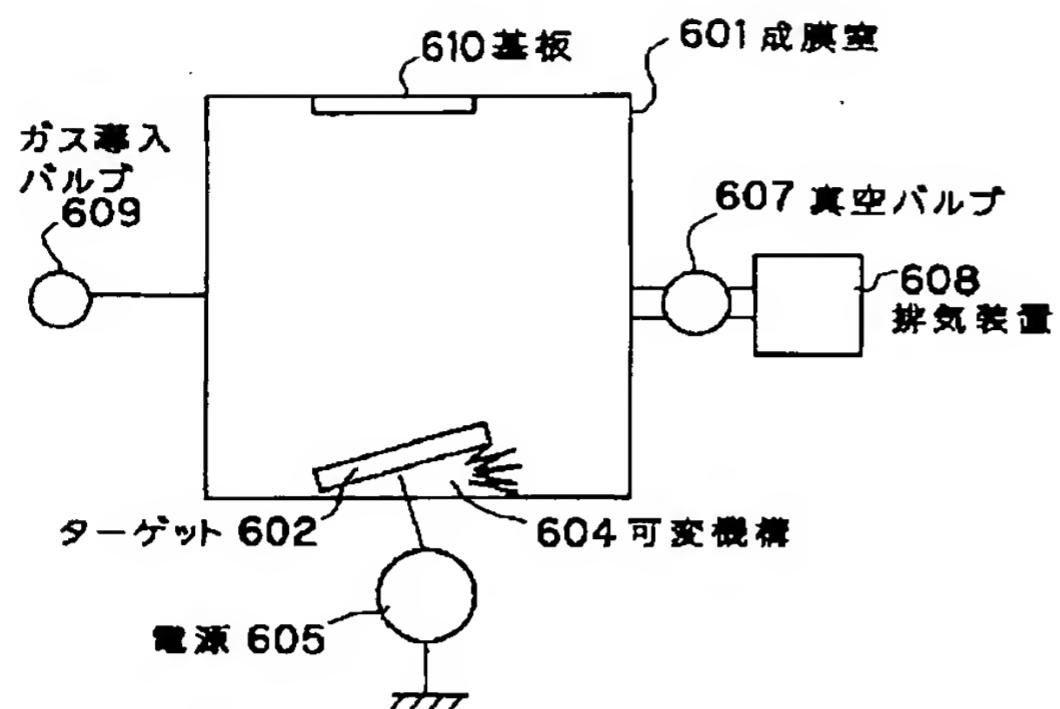
【図10】



【図9】



【図6】



【図8】

